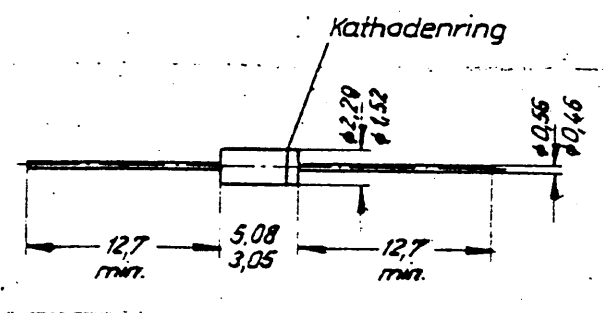


Anwendungscode	
Geräte Klasse	Klima-Klasse n. DIN 40040
K	E J C
ERP-Ber. Nr.:	
Datum:	



1. Eigenschaften
- 1.1. Mechanische Ausführung:
- 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC D035 /DIN
- 1.1.2. Gehäusewerkstoff: Glas
- 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
- 1.1.4. Anschlußdrähte lötlbar verzinnt/vergoldet

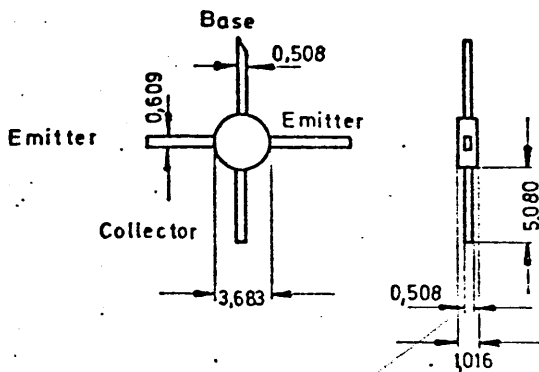
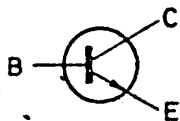
- 1.2. Grenzwerte:
- 1.2.1. Durchbruchspannung:
- 1.2.2. Spitzen-Sperrspannung:
- 1.2.3. Stoßspannung:
- 1.2.4. Durchlaßstrom:
- 1.2.5. Durchlaß-Spitzenstrom:
- 1.2.6. Durchlaß-Stromstoß:
- 1.2.7. Verlustleistung:
- 1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung):
- 1.2.9. Sperrschichttemperatur:
- 1.2.10. Löttemperatur:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{BR}	100 V	$I_R =$ A, $\vartheta_u =$ °C
U_{Rsp}	— V	$\vartheta_u =$ °C
U_{Rstoss}	— V	$\vartheta_u =$ °C
I_F	— A	$\vartheta_u =$ °C
I_{FSP}	0,25 A	$\vartheta_u =$ °C
I_{Fstoss}	— A	$\vartheta_u =$ °C, t = ms
P	250 mW	$\vartheta_u =$ 25 °C
ϑ_s	-65 ... +150 °C	
ϑ_j	-65 ... +150 °C	
ϑ_l	245 °C	t ≧ 5 s
U_F	— V	$I_F =$ A
I_R	≧ 10 µA	$U_R =$ 100 V
I_r	— A	$U_R =$ V, $\vartheta_u =$ °C
R_H	≧ 1500 Ω	$I_F =$ 0,01 mA, f = 100 MHz
R_L	≧ 8 Ω	$I_F =$ 20 mA, f = 100 MHz
R_S	≧ 3,5 Ω	$I_F =$ 100 mA, f = 100 MHz
C_j	≧ 0,4 pF	$U_R =$ 50 V, f = 1 MHz
τ	2 µs	$I_F =$ 50 mA auf $I_R =$ 250 mA
KZ	— 75 dB	} $f_1 = 65$ MHz, $f_2 = 100$ MHz (Zweikanaltest)
C_m	— 75 dB	

1.4. Ubrige elektr. Werte nach Hewlett Packard Katalog (Sept. 1972, S. 57 ff.)

HP 5082-3081

Anwendungscode	
Corbis Klasse	Klima-Klasse n. DIN 42043
K	E E C
ERP-Ber. Nr.:	
Datum:	



1. Eigenschaften
- 1.1. Mechanische Ausführung
- 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC /DIN Stripline
- 1.1.2. Gehäusewerkstoff: Keramik
- 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
- 1.1.4. Anschlußbahnen: vergoldet

- 1.2. Grenzwerte
- 1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
- 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
- 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
- 1.2.4. Kollektorstrom:
- 1.2.5. Verlustleistung:
- 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
- 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
- 1.2.8. Löttemperatur:

- 1.3. Kennwerte bei 25°
- 1.3.1. Kollektor-Reststrom:
- 1.3.2. Emitter-Reststrom:
- 1.3.3. Grenzfrequenz:
- 1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:
- 1.3.5. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:
- 1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:
- 1.3.7. Basis-Sättigungsspannung:
- 1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazität:
- 1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazität:
- 1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:
- 1.3.11. Wärmewiderstand:
- 1.3.12. Rauschzahl:
- 1.3.13. Leistungsverstärkung:
(nicht neutralisiert)

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{CB0}	20 V	$\vartheta_v = -$ °C
U_{CE0}	12 V	$\vartheta_v = -$ °C
U_{EB}	3 V	$\vartheta_v = -$ °C
I_C	100 mA	$\vartheta_v = -$ °C
P_{tot}	400 mW	$\vartheta_G = 25$ °C
ϑ_{100}	-65 bis 200 °C	
ϑ_{10}	200 °C	
ϑ_1	245 °C	$t \leq 5$ s
I_{CBO}	III 0,02 μ A	$U_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$
I_{CBO}	- A	$U_{CB} =$ V, $\vartheta_v =$ °C
I_{EBO}	- A	$U_{EB} =$ V
f_T	IV 3,5 GHz	$U_{CE} = 10$ V, $I_C = 15$ mA, $f = 500$ MHz
B	IV 20	$U_{CE} = 10$ V, $I_C = 15$ mA
h_{fe}		$U_{CE} =$ V, $I_C =$ A, $f =$ KHz
U_{CEsat}	V	$I_C =$ A, $I_B =$ A
U_{CEsat}	V	$I_C =$ A, $I_B =$ A
U_{BEsat}	V	$I_C =$ A, $I_B =$ A
C_{CS}	III 0,5 pF	$U_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$ A, $f = 1$ MHz
C_{ES}	pF	$U_{EB} =$ V, $I_C =$ A, $f =$ MHz
R_{thG}	0,43 °C/mW	
R_{thU}	°C/mW	
NF	III 2,5 dB	$U_{CB} = 10$ V, $I_C = 3$ mA, $f = 10$ GHz
V_p	IV 14 dB	$U_{CB} = 10$ V, $I_C = 15$ mA, $f = 10$ GHz

1.4. Obriige elektr. Werte nach AVANTEK-Datenblatt, AT 50, März 1970

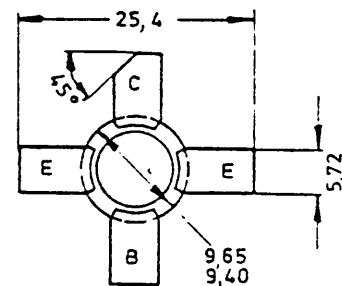
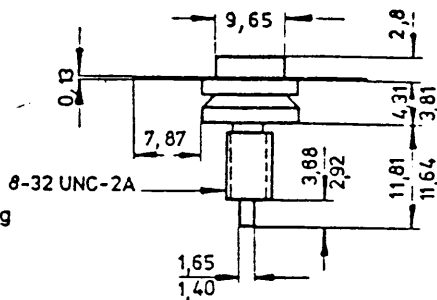
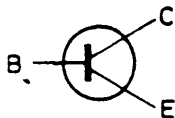
Si-NPN-Transistor

COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION, SAN CARLOS, CALIF.

BAM 20

0.03.88

Anwendungscode	
Geräte Klasse	Klima-Klasse n. DIN 4090
K	E E C
ERP-Bez. Nr.:	
Datum:	



1. **Eigenschaften**
 - 1.1. **Mechanische Ausführung**
 - 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC /DIN
 - 1.1.2. Gehäusewerkstoff: **keramik**
 - 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
 - 1.1.4. Anschlußdrähte lötbar vzin/vgol

- 1.2. **Grenzwerte**
 - 1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
 - 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
 - 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
 - 1.2.4. Kollektorstrom:
 - 1.2.5. Verlustleistung:
 - 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
 - 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
 - 1.2.8. Löttemperatur:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{CB0}	60 V	$\vartheta_v =$ °C
U_{CEO}	35 V	$\vartheta_v =$ °C
U_{EBO}	4 V	$\vartheta_v =$ °C
I_C	2,5 A	$\vartheta_v =$ °C
P_{tot}	25 W	$\vartheta_G = 25$ °C
ϑ_s	-65...+200 °C	
ϑ_i	200 °C	
ϑ_l	260 °C	$t \leq 8$ s

1.3. **Kennwerte bei 25°C**

1.3.1. Kollektor-Reststrom:	I_{CIS}	≤ 20 mA	$U_{CB} = 60$ V
	I_{CBO}	A	$U_{CB} = V, \vartheta_v =$ °C
1.3.2. Emitter-Reststrom:	I_{EBO}	A	$U_{EB} = V$
1.3.3. Grenzfrequenz:	f_T/f_B	Hz	$U_{CE} = V, I_C = A, f =$ MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:	B		$U_{CE} = V, I_C = A$
1.3.5. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:	h_{fe}		$U_{CE} = V, I_C = A, f =$ KHz
1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:	U_{CEsat}	V	$I_C = A, I_B = A$
	U_{CEsat}	V	$I_C = A, I_B = A$
1.3.7. Basis-Sättigungsspannung:	U_{BEsat}	V	$I_C = A, I_B = A$
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazität:	C_{CS}	≤ 13 pF	$U_{CB} = 28$ V, $I_E = A, f = 1$ MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazität:	C_{ES}	pF	$U_{EB} = V, I_C = A, f =$ MHz
1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:	R_{thG}	≤ 7 °C/W	} $U_{CC} = 27$ V, $P_m = 0,75$ W, $f = 150$ MHz
1.3.11. Wärmewiderstand:	R_{thU}	°C/W	
1.3.12. Ausgangsleistung:	P_o	≤ 20 W	
1.3.13. Wirkungsgrad:	η	typ. 65 %	

BeO 5N 9625 Teil 2
(GIFTIG) BEACHTEN

1.4. **Übrige elektr. Werte nach CTC-Datenblatt CT 150-28 (Ausz. Nov. 1972)**

1.5. **Hinweis:** Anzugsdrehmoment f. Befestigungsmutter: 4...6 in pd. ± 46...49 cmH

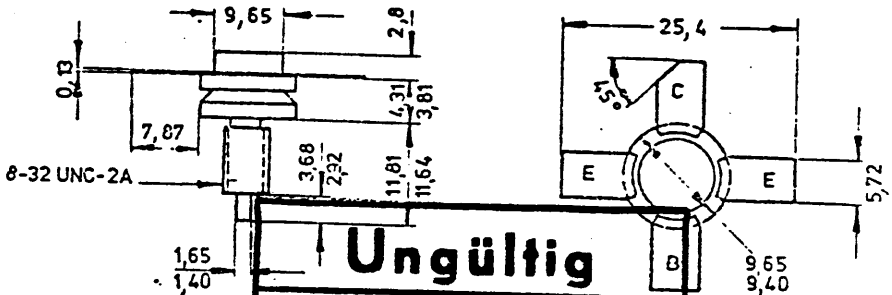
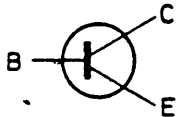
1.6. **Vorsicht:** Dieses Bauteil enthält Beryllium-Oxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik nicht beschädigt wird ist das Teil ungefährlich.

SI-NPN - Transistor

COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION, SAN CARLOS CALIF

BAM 4D

Anwendungscode	
Geräte Klasse	Klima-Klasse n. DIN 40040
K	E E C
ERP-Bez. Nr.:	
Datum:	



Ungültig

Ersatz: 1L 5512T 8

X.M. Nr. 40026

Tag: 9.6.88

1. Eigenschaften

- 1.1. Mechanische Ausführung
 - 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC /DIN
 - 1.1.2. Gehäusewerkstoff:
 - 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
 - 1.1.4. Anschlußdrähte lötlbar vzin/vgol

1.2. Grenzwerte

- 1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung:
- 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
- 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
- 1.2.4. Kollektorstrom:
- 1.2.5. Verlustleistung:
- 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
- 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
- 1.2.8. Löttemperatur:

1.3. Kennwerte bei 25° C

- 1.3.1. Kollektor-Reststrom:
- 1.3.2. Emitter-Reststrom:
- 1.3.3. Grenzfrequenz:
- 1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:
- 1.3.5. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:
- 1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:
- 1.3.7. Basis-Sättigungsspannung:
- 1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazität:
- 1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazität:
- 1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:
- 1.3.11. Wärmewiderstand:
- 1.3.12. Ausgangsleistung:
- 1.3.13. Wirkungsgrad:

Formelzeichen	Wert	Meßbedingung
U_{CB0}	50 V	$\vartheta_u =$ °C
U_{CEO}	35 V	$\vartheta_u =$ °C
U_{EBO}	4 V	$\vartheta_u =$ °C
I_C	5 A	$\vartheta_u =$ °C
P_{tot}	50 W	$\vartheta_u = 25$ °C
ϑ_s	-65...+200 °C	
ϑ_i	200 °C	
ϑ_l	260 °C	$t_{in} = 8$ s
I_{CES}	≤ 20 mA	$U_{CE} = 50$ V
I_{CBO}	— A	$U_{CB} = V, \vartheta_u =$ °C
I_{EBO}	— A	$U_{EB} = V$
f_T/f_B	— Hz	$U_{CE} = V, I_C =$ A, $f =$ MHz
B		$U_{CE} = V, I_C =$ A
h_{fe}		$U_{CE} = V, I_C =$ A, $f =$ KHz
U_{CEsat}	— V	$I_C = A, I_B =$ A
U_{CEsat}	— V	$I_C = A, I_B =$ A
U_{BEsat}	— V	$I_C = A, I_B =$ A
C_{CS}	≤ 25 pF	$U_{CB} = 28$ V, $I_E =$ A, $f =$ MHz
C_{ES}	pF	$U_{EB} = V, I_C =$ A, $f =$ MHz
R_{thG}	3.5 °C/W	
R_{thU}	— °C/mW	
P_0	≈ 40 W	$U_{CC} = 27$ V, $P_m = 4$ W, $f = 150$ MHz
η	typ. 65 %	

BeO 5N 9625 Teil 2
(GIFTIG) BEACHTEN

1.4. Übrige elektr. Werte nach CTC-Datenblatt CT 150-28 (Ausz. 1972)

1.5. Hinweis: Anzugsdrehmoment f. Befestigungsmutter: 4...6 in pd \approx 46...49 cmN

1.6. **Vorsicht:** Dieses Bauteil enthält Beryllium-Oxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik nicht beschädigt wird ist das Teil ungefährlich.

Transistor NPN-Silizium

Anwendungscode

Communications Transistor Corporation, San Carlos Calif.

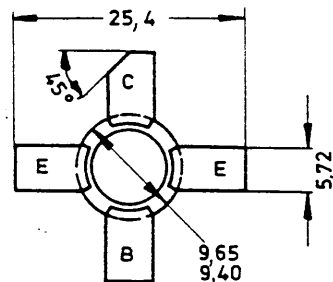
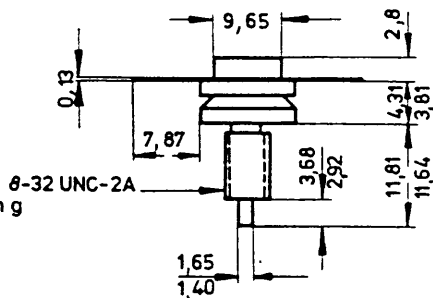
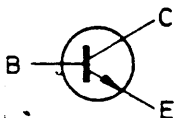
BAM 80

Gerade Klasse Klima-Klasse
n. DIN 40040

K E E F

ERP-Ber. Nr.: —

Datum: —



1. Eigenschaften

1.1. Mechanische Ausführung

- 1.1.1. Gehäuseart: JEDEC /DIN
- 1.1.2. Gehäusewerkstoff: Keramik
- 1.1.3. Gehäuseoberfläche:
- 1.1.4. Anschlüsse lötbar vgl

1.2. Grenzwerte

- 1.2.1. Kollektor-Emitter-Spannung:
- 1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
- 1.2.3. Emitter-Basis-Spannung:
- 1.2.4. Kollektorstrom:
- 1.2.5. Verlustleistung:
- 1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung):
- 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
- 1.2.8. Löttemperatur:

Formelzeichen	Wert	Meßbeding
U_{CBO}	60 V	$\theta_v = -$ °C
U_{CEO}	35 V	$\theta_v = -$ °C
U_{EBO}	4 V	$\theta_v = -$ °C
I_C	8,5 A	$\theta_v = -$ °C
P_{tot}	85 W	$\theta_G = +25$ °C
θ_s	-65...+200 °C	
θ_i	+200 °C	
θ_l	+260 °C	$t \leq 5$ s
I_{CES}	20 mA	$U_{CE} = 60$ V
I_{CBO}	— A	$U_{CB} = -$ V, $\theta_v = -$ °C
I_{EBO}	— A	$U_{EB} = -$ V
f_T/f_B	— Hz	$U_{CE} = -$ V, $I_C = -$ A, $f = -$ MHz
B	—	$U_{CE} = -$ V, $I_C = -$ A
h_{fe}	—	$U_{CE} = -$ V, $I_C = -$ A, $f = -$ KHz
U_{CEsat}	— V	$I_C = -$ A, $I_B = -$ A
U_{CEsat}	— V	$I_C = -$ A, $I_B = -$ A
U_{BEsat}	— V	$I_C = -$ A, $I_B = -$ A
C_{CS}	75 pF	$U_{CB} = 28$ V, $I_E = -$ A, $f = 1$ MHz
C_{ES}	— pF	$U_{EB} = -$ V, $I_C = -$ A, $f = -$ MHz
R_{thG}	2 °C/W	
R_{thU}	— °C/mW	
P_O	80 W	$U_{CC} = 27$ V, $P_m = 10$ W, $f = 150$ MHz
η	typ. 65 %	

BeO 5N 9625 Teil 2
(GIFTIG) BEACHTEN

1.3. Kennwerte bei 25° C

- 1.3.1. Kollektor-Reststrom:
- 1.3.2. Emitter-Reststrom:
- 1.3.3. Grenzfrequenz:
- 1.3.4. Gleichstrom-Verstärker-Faktor:
- 1.3.5. Wechselstrom-Verstärker-Faktor:
- 1.3.6. Kollektor-Sättigungsspannung:
- 1.3.7. Basis-Sättigungsspannung:
- 1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazität:
- 1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazität:
- 1.3.10. Wärme-Innenwiderstand:
- 1.3.11. Wärmewiderstand:
- 1.3.12. Ausgangsleistung:
- 1.3.13. Wirkungsgrad:

1.4. Übrige elektr. Werte nach CTC-Datenblatt CT 150-28 (Ausg. Nov. 1972)

1.5. Hinweis: Anzugsdrehmoment f. Befestigungsmutter: 4...6 in pd $\hat{=}$ 46...49 cmN

1.6. **Vorsicht**: Dieses Bauteil enthält Beryllium-Oxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik nicht beschädigt wird ist das Teil ungefährlich.